

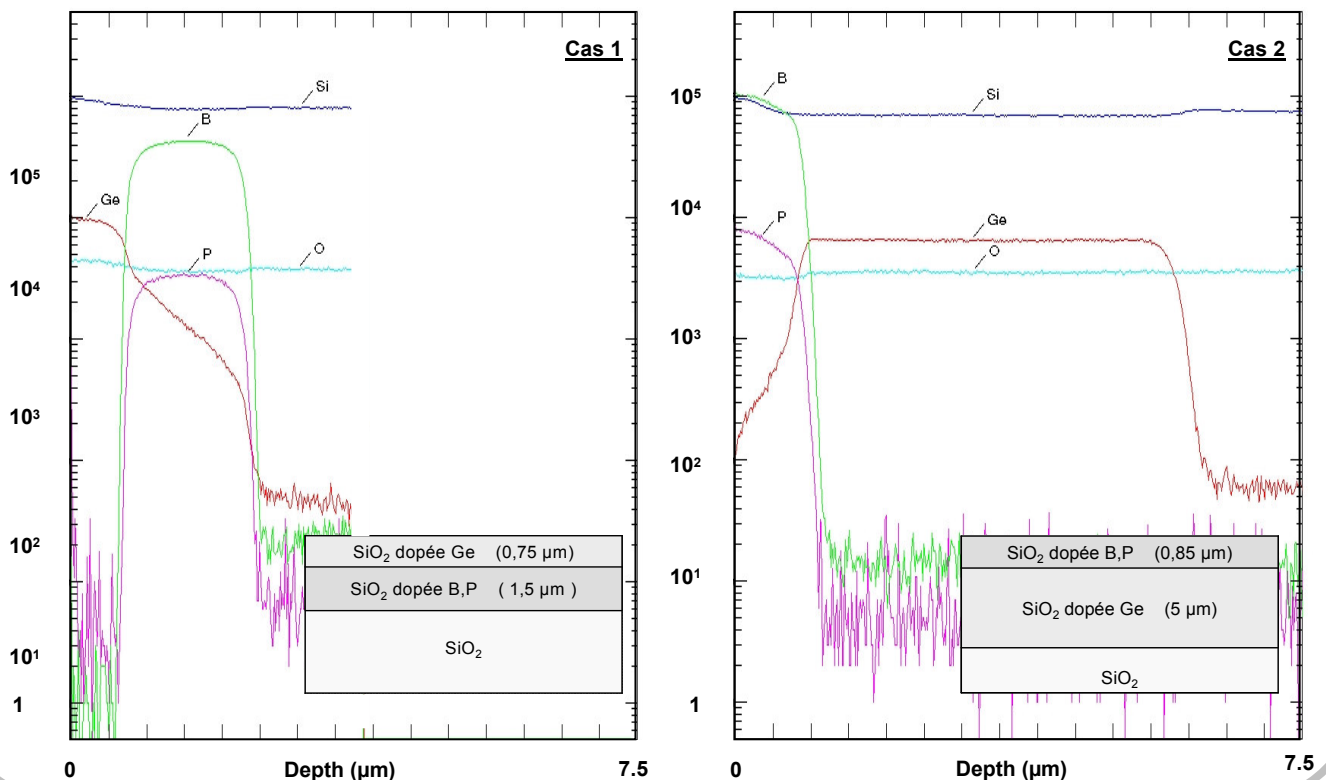
V2

Objet : Caractérisation d'empilements de couches minces isolantes de silice dopée par des éléments d'addition en forte teneur (quelques % at.) dans le but de connaître leur distribution

Technique mise en œuvre : **SIMS**

- ✓ Epaisseur des couches → quelques 0.1 µm à quelques µm
- ✓ Résolution en profondeur de l'ordre du nm → étude de la diffusion
- ✓ Profils élémentaires de répartition en profondeur → localisation des dopants

Résultats :



Conclusion :

- ⇒ **Cas 1** : diffusion du dopant Ge de la couche superficielle dans la sous-couche dopée B et P. Aucune diffusion des dopants B et P.
- ⇒ **Cas 2** : diffusion du dopant Ge de la sous-couche dans la couche superficielle dopée B et P. Aucune diffusion des dopants B et P.